

Арсенид Галлия (GaAs)

Арсенид Галлия (GaAs)

Производитель:

АО «Диполь Технологии»

Цена:

Цена по запросу

Описание

GaAs - это полупроводниковый материал с превосходными эксплуатационными характеристиками, включая большую ширину запрещенную зону, высокую подвижность электронов и высокую эффективность преобразования.

Арсенид галлия часто используется в качестве материала подложки для эпитаксиального выращивания других полупроводников III-V типа, включая арсенид индия-галлия, арсенид алюминия-галлия и других.

Применение

Арсенид галлия применяется для изготовления полевых транзисторов с эффектом Шоттки (ПТШ), фотоэлементов, полупроводниковых лазеров с длиной волны излучения 0,83-0,92 мкм, интегральных микросхем повышенного быстродействия и степени интеграции на полевых транзисторах с эффектом Шоттки, фотокатодов с малой работой выхода электронов, туннельных диодов, диодов Ганна.

Спецификация

Арсенид Галлия (GaAs)

Подложки GaAs с другими параметрами также доступны по запросу.

Производство: Китай, Малайзия, Турция. Также доступны эпитаксиальные структуры на основе GaAs.